第48卷第4期/2021年2月/中国激光

中国鼎光

高能激光单晶硅反射镜纳米精度控形控性制造技术

石峰^{1,2}*,田野^{1,2**},乔硕^{1,2,3***},周光奇^{1,2},宋辞^{1,2},薛帅^{1,2},铁贵鹏^{1,2},周林^{1,2},

舒勇4,周港1,2

¹国防科技大学智能科学学院,湖南 长沙 410073; ²国防科技大学装备综合保障技术重点实验室,湖南 长沙 410073; ³长沙学院机电工程学院,湖南 长沙 410022;

*空军工程大学航空机务士官学校,河南 信阳 464000

摘要 单晶硅反射镜是高能激光系统中的重要元件,其加工质量直接影响着高能激光系统的整体性能指标。针对 单晶硅反射镜加工过程中产生的各类缺陷问题,本研究团队提出了采用超精密切削、浸没式抛光、磁流变抛光、离 子束抛光等超精密加工方法来提升单晶硅元件的加工质量,并开展了相关研究。本文主要综述了本团队近几年在 单晶硅制造技术领域取得的研究进展,包括单晶硅纳米精度表面控形制造技术、单晶硅纳米精度本征表面控性生 成方法、纳米精度控形控性组合工艺等一系列关键技术。通过探讨高能激光单晶硅元件制造的现状与关键技术, 为实现单晶硅元件纳米精度控形控性制造提供技术支撑。

关键词 光学制造;高能激光系统;单晶硅元件;浸没式光顺抛光;离子束抛光

中图分类号 O436 **文献标志码** A

1 引 言

在红外高能激光系统中,单晶硅反射镜被广泛 使用^[1]。反射镜需要在高功率密度激光的长时间辐 照下实现高精度、高稳定性的光束传输,对元件精度 与激光负载能力都有着极高的要求^[2-3]。为了提升 高通量强光元件的成形、成性以及高效率经济制造, 国内外研究人员近几年致力于研究获得单晶硅元件 本征表面的加工方法与工艺,包括弹塑性域材料去 除与清洗技术等^[4-8]。但目前尚缺乏基底加工工艺、 残余缺陷、吸收率之间关系的研究,且无完备的理论 来阐述如何同时提升元件的加工精度和激光负载能 力。因此,通过开展制造方法与工艺方面的研究,结 合应用特点创新制造技术获得低损伤洁净表面,成 为进一步提升元件激光负载能力的新思路和技术发 展趋势。本课题组提出的使用磁流变、离子束等可 控柔体加工技术提升了单晶硅元件的激光负载能 力,突破了纳米精度表面控形制造技术、纳米精度本 征表面控性生成方法、单晶硅高精度低缺陷组合工 艺等一系列关键技术,提高了单晶硅元件的加工效 率和加工效果,为单晶硅元件的高精度低缺陷控形 控性制造提供了一条新的技术途径。

doi: 10.3788/CJL202148.0401007

2 纳米精度表面控形制造技术

随着激光系统能量传输比和辐照距离的不断提 升,对光学零件质量的要求也日益提高。纳米精度 制造要求全频段误差一致收敛到纳米量级,此时宏 观尺度的面形误差和中高频粗糙度将处于同一数量 级,它们之间的关联性将明显增强。在多年的研究 中,本研究团队大力发展了超精密切削、磁流变、离 子束和保形光顺技术,目的是获得全频段亚纳米精 度光学表面。

2.1 低频面形误差——超精密切削、磁流变

目前,平面单晶硅的磨削缺陷已经得到很好的

收稿日期: 2020-08-20; 修回日期: 2020-09-22; 录用日期: 2020-11-02

基金项目:NSFC-广东联合基金(U1801259)、国家自然科学基金(51835013,51675526)、湖南省科技创新计划 (2020RC2037)、湖南省教育厅科学研究项目(20C0151)

^{*}E-mail: shifeng@nudt.edu.cn; **E-mail: tianyecomeon@ sina.cn ***E-mail: z20190623@ccsu.edu.cn

综 述

第48卷第4期/2021年2月/中国激光

抑制,甚至可以直接使用超精磨制造出光学表面。 澳大利亚昆士兰大学的 Zhang^[9]、日本茨城大学的 Zhou 等^[10-11]、中国大连理工大学的康仁科等^[12]均 通过化学机械磨削方法获得了高质量表面,但在曲 面单晶硅磨削中尚未完全解决亚表面损伤的问题。 近年来,单晶硅超精密切削技术逐渐成熟,该技术通 过超声振动、纳米冷却液等有效抑制了刀具的磨损, 提升了表面质量。金钊等^[13]采用 MgO 软磨料砂轮 进行了纳米精度的单晶硅磨削,亚表面损伤接近于 零。哈尔滨工业大学的陈冰^[14]在非球面磨削中将 亚表面缺陷深度控制在了 5 μm 左右。本研究团队 通过高速度、高刚度、微粒径的超精密磨削加工进一 步提升了面形精度,减小了缺陷层的深度^[15]。本研 究团队对超精密磨削的损伤层深度进行了理论计算 与实际测试。图 1 展示了不同亚表面深度时暴露出 的缺陷情况,当深度达到 3 μm 时观测表面无缺陷, 可以认为该组工艺条件下,超精密磨削的亚表面缺 陷深度约为 3 μm。





图 1 单晶硅超精密磨削后的缺陷深度。(a)初始表面,深度为 0;(b)深度为 1.5 μm;(c)深度为 2.5 μm;(d)深度为 3 μm Fig. 1 Defect depth distribution after ultra-precision grinding of single crystal silicon. (a) Original surface, depth is 0; (b) depth is 1.5 μm; (c) depth is 2.5 μm; (c) depth is 3 μm

磁流变抛光技术是利用磁流变抛光液在磁场中 的流变性进行抛光的一种超精密加工方法,其独特 的剪切加工特性能够使单晶硅在加工过程中不产生 破碎缺陷。湖南大学的尹韶辉等^[16]使用斜轴磁流 变抛光技术高效率地制造了小口径单晶硅非球面 镜,其粗糙度均方根(RMS)小于 1 nm,面形精度 (峰谷值)小于 69 nm。本研究团队基于弹性接触力



学和双刃圆模型,分析了磁流变弹性域加工的条件, 认为弹性域化学加工是实现磁流变超光滑无损加工 的重要条件。

图 2 为单晶硅磁流变抛光实验,工艺实验表明, 处于弹塑性域的磁流变抛光过程包含化学辅助过程,能够有效去除破碎缺陷,改善表面粗糙度,对提 升元件的阈值大有裨益。



图 2 单晶硅磁流变抛光。(a)加工中;(b)加工后 Fig. 2 Single crystal silicon magnetorheological polishing. (a) Polishing process; (b) after polishing

2.2 中高频误差----保形光顺

光学元件中高频误差的高低直接关系到整个系 统的成败。光顺加工是控制光学镜面高频误差的最 重要手段之一,对于光学元件全频段误差的一致收 敛具有重要意义。

对于中频误差,一般在精抛光阶段插入光顺工 艺加以抑制。光顺工艺利用抛光盘的刚度在中频误 差的高点处产生比低点处更大的抛光压强来优先去 除局部高点误差,使中频误差收敛。但单晶硅强激 光反射镜中大量采用的是非球面设计,甚至包括柱 面设计,光顺工艺无法直接应用。如图 3 所示,本研 究团队基于原有工艺,创新性地采用柱面光顺半刚 性光顺盘,结合浸没式抛光,实现了中频误差和表面 缺陷的同时抑制^[17]。高频误差由材料去除过程中 的微观行为产生。高频误差尺度仅为纳米量级,因 此只需要几个原子层的去除就会发生显著变化。离 子束垂直入射时不会引入新的高频误差。在化学机 械地光过程中,利用纳米颗粒与工件之间的化学反 应也可以进行原子级材料的去除。基于上述理论准 备和工艺优化,本研究团队运用基于光顺和子口径 抛光技术的联合工艺链,成功实现了各型光学元件 中高频误差的控制。



图 3 柱面光顺工艺^[17]。(a)柱面光顺实物图;(b)半刚性柱面光顺盘;(c)光顺前的局部中频误差;(d)光顺后的局部中频误差 Fig. 3 Cylindrical smoothing process^[17]. (a) Practical equipment for cylindrical smoothing process; (b) semi-rigid cylindrical smoothing plate; (c) mid spatial frequency error before smoothing; (d) mid spatial frequency error after smoothing

3 纳米精度本征表面控性生成方法

在机械抛光处理过程中,单晶硅表面一般会出 现一些典型的损伤前驱体,如吸收性杂质、裂纹、划 痕等,这些损伤前驱体的种类和密度严重制约了光 学元件的抗损伤性能。纳米损伤前驱体作为表面、 亚表面缺陷的新形态,一般可分为机械型、污染型、 结构型三类。本研究团队对单晶硅本征表面加工方 法与工艺进行了一系列研究,通过浸没式抛光、离子 束等技术去除了光学元件的表面缺陷,获得了纳米精 度的本征表面,提升了单晶硅元件的激光负载能力。

3.1 机械型表面缺陷----浸没式抛光加工

为了解决抛光过程中的划痕问题,本研究团队将 浴法抛光工艺与普通的计算机控制光学表面成形 (CCOS)工艺结合在一起,在工件完全浸没于抛光液 中的情况下,开展了 CCOS 抛光加工^[18],如图 4 所 示。相比于在空气中抛光,抛光液中的粗大颗粒更难 进入抛光界面,表面划痕、凸线形成的划擦条件无法 达到,表面缺陷得以抑制。对于浸没式抛光加工,需 要定期检测并调控抛光液的 pH,一旦大颗粒得到控 制,表面划痕、凸线形成的划擦条件便无法达到,从而 可以实现表面缺陷的有效抑制,如图 5 所示。



图 4 传统抛光与浸没式抛光。(a)传统抛光装置;(b)浸没式抛光装置

Fig. 4 Traditional polishing and immersion polishing equipment. (a) Traditional polishing equipment; (b) immersion polishing equipment



图 5 通过大颗粒隔离实现的表面缺陷抑制。(a)空气中抛光,表面划痕;(b)空气中抛光,表面凸线;(c)浸没式抛光,表面无缺陷 Fig. 5 Surface defect suppression realized by isolating large particles. (a) Scratches on polished surfaces in air; (b) convex line on polished surfaces in air; (c) immersive polishing, without surface defects

3.2 污染型缺陷——大束流离子束清洗

除表面划痕外,单晶硅的亚表面材料在加工过 程中也会产生杂质污染。为了降低污染型缺陷对元 件激光负载能力的影响,美国的国家点火设施 (NIF)采用兆声波酸洗工艺^[19],用一定浓度的 HF 酸作为腐蚀液浸泡工件,以去除污染提升阈值。一 方面,元件表面面形不可控,在酸蚀过程中可能会遭 到严重破坏;另一方面,酸蚀反应产物的溶解度有 限,沉积后会形成二次污染,反而会降低元件的激光 损伤阈值。



本研究团队创新性地提出了使用离子刻蚀工艺 来去除污染型缺陷,该工艺利用离子源发射的离子 束流轰击光学镜面时发生的物理溅射效应来达到去 除光学元件表面材料的目的^[20-22],如图 6 所示。加 工过程中使用聚焦离子源发射出的离子束轰击光学 镜面,当表面原子获得的能量大于表面束缚能时,原 子就会脱离工件表面。宏观上,工件的表面材料就 被离子刻蚀去除。离子刻蚀工艺在去除纳米点状微 结构吸收前驱体的基础上,不会引入新缺陷,是一种 有效的缺陷抑制手段。



图 6 离子束加工设备与物理溅射过程示意图^[22]。(a)离子束加工设备;(b)物理溅射过程示意图

Fig. 6 Ion beam processing equipment and physical sputtering process. (a) Ion beam processing equipment; (b) physical sputtering process

3.3 结构型缺陷——离子束抛光(倾斜入射)

在单晶硅元件的加工过程中,化学键的断裂和 杂质离子的引入,会在材料体内产生大量的化学结 构缺陷。这些缺陷会降低单晶硅元件的激光负载 能力。

如图7所示,本研究团队通过调整入射角、离子



能量等参数,在单晶硅表面获得了近本征表面,其粗 糙度 RMS 小于 0.1 nm^[23]。进一步,配合中频误差 抑制工艺,本研究团队在不同尺寸的非球面元件上 实现了全频段亚纳米精度制造。离子束工艺是实现 单晶硅非球面反射镜高精度、低缺陷、低污染制造的 首选工艺之一。



图 7 离子束倾斜入射实验^[23]。(a)实验照片;(b)工件面形误差分布

Fig. 7 Tilted incident experiments of ion beam^[23]. (a) Experimental photo; (b) surface error map

纳米精度控形控性组合工艺 4

为了达到纳米精度表面控形控性的目标,本闭 队在深入研究各种加工工艺的基础上,提出了高精 度低缺陷组合工艺。该工艺区别于传统加工中各工 艺的简单衔接转换,而是将全部指标的实现合理地





分配到全工艺流程中,实现了单晶硅元件的高精度 低缺陷控形控性制造。

4.1 组合工艺研究

本团队在深入研究纳米精度表面控形控性技术 的基础上,形成了独特的单晶硅元件加工工艺,其典 型的工艺流程如图 8 所示。



图 8 组合工艺路线。(a)浸没式抛光:(b)离子束修形:(c)面形精度测量 Fig. 8 Combined process route. (a) Immersion polishing; (b) ion beam figuring; (c) profile accuracy measurement

图 8 中的组合工艺以单晶硅元件精度的提升与 缺陷抑制为目标。在精度提升方面,超精磨后利用 CCOS小磨头粗抛光和离子束工艺完成低频误差的 确定性收敛,然后依靠浸没式光顺抑制中频误差,为 低频修形打开空间,同时作为前两者的衔接。浸没 式光顺还能实现高频精度的提升,总体上达到全频 段误差收敛。在缺陷抑制方面,超精磨可有效地将 磨削缺陷深度控制在 3 µm 左右,表面加工缺陷可 以通过浸没式抛光进行有效抑制。利用该组合工艺 可以实现单晶硅元件的高精度低缺陷加工。

4.2 组合工艺与传统工艺的对比

为了对比传统工艺与组合工艺所制造的元件的 激光性能,本研究团队分别采用两种工艺制造了一 件相同规格(Φ 200 mm×45 mm)的平面反射镜,并 进行了等功率密度测试。编号为 A 和 B 的样件分 别对应传统工艺与组合工艺,如图 9 所示。



图 9 平面反射镜样件实物图 Fig. 9 Samples of plane mirror

在样件 B 的测试过程中,波前误差从初始的 0.1 μm(峰谷值)缓慢变化至 0.4 μm(峰谷值),最 终仅为样件 A 的 5% 左右。同时, 样件 B 的表面荧 光点亮度与密度均小于样件 A,在样件 B 表面观测 到的膜层损伤在密度和程度上都更小。从膜层损伤 形态上来看,传统工艺制造的元件表面发生了多处 膜层损伤,膜层破坏严重,损伤尺寸接近毫米级,而 组合工艺制造的元件表面多以疖瘤缺陷诱发的小损 伤坑为主,损伤坑的直径均在 20 μm 左右,明显优 于传统工艺。组合工艺制造的元件的表面损伤未引 起能量吸收率的突变。进一步对比分析后发现,样 件 B 的激光性能显著优于样件 A,验证了全频段高 精度低缺陷加工对元件性能提升的必要性,显示出 了组合工艺的价值。

4.3 柱面元件高精度低缺陷加工实例

某型凸柱面镜是激光束发射出真空腔前反射经 过的最后一个元件,在实际应用中,其损伤概率是光 路中其他元件的数倍,需要频繁更换。当前柱面元 件的激光负载能力无法满足需要,成为了整条光路 的短板,因此需要使用更高质量的凸柱面反射镜来 提升系统的寿命与可靠性。某型凸柱面镜元件实物 如图 10 所示。



图 10 凸柱面镜实物图 Fig. 10 Picture of convex cylindrical mirror

综 述

本研究团队采用组合工艺,通过引入柱面光顺 工艺、浸没式抛光工艺与离子束抛光工艺的组合,实 现了控形控性加工。组合工艺加工结果如图 11 所 示,低频面形误差 RMS 为 13.54 nm,中频面形误 差 RMS 为 0.494 nm,高频面形误差 RMS 为 0.261 nm,暗场检测无可视缺陷。组合工艺表现出 了良好的非球面适应性,实现了柱面元件全频段精 度收敛和缺陷抑制。



图 11 凸柱面镜的加工结果。(a)低频面形误差 RMS 为 13.537 nm;(b)中频面形误差 RMS 为 0.494 nm;(c)高频面形误差 RMS 为 0.261 nm

Fig. 11 Processing results of convex cylindrical mirror. (a) RMS of low spatial frequency surface shape error is 13.537 nm;
(b) RMS of middle spatial frequency surface shape error is 0.494 nm;
(c) RMS of high spatial frequency surface shape error is 0.261 nm

5 结束语

本文综述了近几年本研究团队在单晶硅元件高 精度低缺陷控形控性制造技术方面取得的主要成 果。本团队研发的高精度低缺陷组合加工工艺已经 应用在单晶硅强光光学元件的加工过程中,为高能 激光系统的发展提供了支撑。

参考文献

- Wang G L, Feng Z J, Zheng Q C, et al. Molecular dynamics simulation of nano-polishing of single crystal silicon on non-continuous surface [J]. Materials Science in Semiconductor Processing, 2020, 118: 105168.
- [2] Yu D M, Duan W B, Li D Q, et al. Design and fabrication of polarization- and phase-modulated mirror [J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40 (15): 1531001
 余德明,段微波,李大琪,等.偏振和相位调控反射
 镜的设计与制备[J].光学学报, 2020, 40 (15): 1531001
- [3] Shao S C, Tao X P, Wang X K. On-machine surface shape measurement of reflective mirrors by ultraprecision turning based on fringe reflection[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(7): 071203.
 邵山川,陶小平,王孝坤.基于条纹反射的超精密车 削反射镜的在位面形检测[J].激光与光电子学进展, 2018, 55(7): 071203.
- [4] Zegrya A G, Sokolov V V, Zegrya G G, et al. The

effect of the doping level of starting silicon single crystals on structural parameters of porous silicon produced by electrochemical etching [J]. Technical Physics Letters, 2019, 45(11): 1067-1070.

- [5] Tian Y, Shi F, Dai Y F, et al. Laser absorption precursor research: microstructures in the subsurface of mono-crystalline silicon substrate [J]. Applied Optics, 2017, 56(30): 8507-8512.
- [6] Tian Y, Dai Y F, Shi F, et al. Correlation between substrate surface quality and laser energy absorption rate for mono-crystalline silicon reflector[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2015, 37(6): 26-29.

田野,戴一帆,石峰,等.单晶硅反射镜激光能量吸 收系数与衬底表面质量的关联[J].国防科技大学学 报,2015,37(6):26-29.

- [7] Wang P Z, Wang B, Melkote S N. Modeling and simulation of phase transformation and crack formation during scribing of mono-crystalline silicon
 [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 175: 105527.
- [8] Zhang X, Huang T, Xiao R S. Behavior characteristics of different crystal surfaces of monocrystal silicon under femtosecond laser irradiation [J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(1): 0102012.
 张欣,黄婷,肖荣诗.不同晶面单晶硅在飞秒激光作用下的行为特性[J].中国激光,2017,44(1): 0102012.
- [9] Zhang L C, Zarudi I. Towards a deeper understanding of plastic deformation in monocrystalline silicon [J]. International Journal of

Mechanical Sciences, 2001, 43(9): 1985-1996.

- [10] Zhou L B, Kawai S, Honda M, et al. Research on chemo-mechanical-grinding (CMG) of Si wafer. 1st report: development of CMG wheel [J]. Journal of the Japan Society for Precision Engineering, 2002, 68 (12): 1559-1563.
- [11] Zhou L B, Kawai S, Honda M, et al. Research on chemo-mechanical-grinding (CMG) of Si wafer. 2nd report: generation of defect free surface on \$\varphi\$300 mm Si wafer by fixed abrasive process[J]. Journal of the Japan Society for Precision Engineering, 2005, 71 (4): 466-470.
- [12] Kang R K, Tian Y B, Guo D M. An ultra-precision grinding wheel for hard and brittle crystal substrates: CN1951635[P]. 2007-04-25.
 康仁科,田业冰,郭东明,等.一种硬脆晶体基片超 精密磨削砂轮: CN1951635[P]. 2007-04-25.
- [13] Jin Z, Li J S, Kang R K, et al. Ultra-precision manufacturing technology with soft abrasive grinding for silicon [J]. Opto-Electronic Engineering, 2011, 38(12): 75-80.
 金钊,李锦胜,康仁科,等.应用软磨料磨削的单晶 硅超精密制造技术[J].光电工程, 2011, 38(12): 75-80.
- [14] Chen B. Key technology on ultra-precision grinding of infrared aspheric lens [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2015.
 陈冰. 红外材料非球面透镜的超精密磨削加工关键 技术研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2015.
- [15] Niu Y J, Dai Y F, Guan C L, et al. Study on the technology of ultra-precision grinding for aspheric mirror of monocrystalline silicon [C]//The 6th International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology. Harbin: [s.n.], 2015.
- [16] Yin S H, Chen F J, Zhang D C, et al. Nanoprecision finishing process integrated with ELIDgrinding and MRF for silicon mirror [J]. Nanotechnology and Precision Engineering, 2007, 5

(3): 220-223.

尹韶辉, 陈逢军, 张导成, 等. 结合 ELID 磨削与磁 流变光整加工的单晶硅反射镜超精密制造技术 [J]. 纳米技术与精密工程, 2007, 5(3): 220-223.

- [17] Tian Y. The key technology research of high-precision and low-defect fabrication for silicon reflectors [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2018.
 田野.单晶硅反射镜高精度低缺陷制造关键技术研究[D].长沙:国防科技大学, 2018.
- [18] Shen Z X, Ma B, Wang Z S, et al. Fabrication of flat and supersmooth surfaces with bowl-feed polishing process [J]. Proceedings of SPIE, 2007, 6722: 67220U.
- [19] Suratwala T I, Miller P E, Bude J D, et al. HFbased etching processes for improving laser damage resistance of fused silica optical surfaces [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94(2): 416-428.
- [20] Chen M Y, Cheng W M, Wang C W W. Multiaperture overlap-scanning technique for largeaperture test[J]. Proceedings of SPIE, 1992, 1553: 626-635.
- [21] Cheng W M, Chen M Y. Transformation and connection of subapertures in the multiaperture overlap-scanning technique for large optics tests[J]. Optical Engineering, 1993, 32: 1947-1950.
- [22] Zhou L. Study on theory and technology in ion beam figuring for optical surfaces[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2008.
 周林.光学镜面离子束修形理论与工艺研究[D].长沙:国防科学技术大学, 2008.
- [23] Song C, Tian Y, Shi F, et al. Process optimization for cylindrical single-crystal silicon mirror with a tilted incident ion beam figuring [J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(12): 1222001.
 宋辞,田野,石峰,等.单晶硅柱面反射镜离子束倾 斜入射加工工艺优化[J].光学学报, 2020, 40(12): 1222001.

Nanoprecision Control of Shape and Performance Manufacturing Technology for High-Energy Laser Silicon Components

Shi Feng^{1,2*}, Tian Ye^{1,2**}, Qiao Shuo^{1,2,3***}, Zhou Guangqi^{1,2}, Song Ci^{1,2}, Xue Shuai^{1,2}, Tie Guipeng^{1,2}, Zhou Lin^{1,2}, Shu Yong⁴, Zhou Gang^{1,2}

¹ College of Intelligence Science, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China; ² Key Laboratory of Science and Technology on Integrated Logistics Support, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073, China;

³ College of Electromechanical Engineering, Changsha University, Changsha, Hunan 410022, China;

⁴Aviation Maintenance NCO Academy, Air Force Engineering University, Xinyang, Henan 464000, China

Abstract

Significance In high-power infrared laser systems, monocrystalline silicon reflectors are widely used, and the reflectors need to achieve high-precision, high-stability beam transmission under high-power laser irradiation for long durations. The high accuracy of components and laser load capacity are both highly desired. With the continuous development of high-energy laser technology, the performance of existing monocrystalline silicon components has been unable to support the further improvement of system output power and performance, which has become a technical shortcoming. A high-energy laser system requires optimum reflector performance in systems, i. e., precision and laser load capacity. The pursuit of full-frequency spatial error restraint and reduction of laser energy absorption rate depends on fabrication quality. However, at present, fabrication technology inherits from traditional optical processing, and it is difficult to achieve both precision and laser load capability. Accordingly, it is necessary to investigate manufacturing methods and processes and combine innovative manufacturing techniques with application characteristics. By discussing the present situation and key technology of monocrystalline silicon component manufacturing, we hope technical support for realizing nanoprecision shape control manufacturing of monocrystalline silicon can be provided.

Progress This article summarizes the current status of and difficulties in manufacturing high-energy laser aspheric components and reveals the typical processing defect morphology and generation mechanism that reduce the laser load capacity. Based on the realization of high-precision processing of aspherical components, the role of new methods of controllable flexible body processing based on immersion smooth polishing, ion beam sputtering cleaning, and other methods in controlling defects is discussed to realize the formation of high-energy laser aspherical components. The specific research includes the following aspects:

(1) Nanoprecision surface shape control manufacturing technology. With continuous improvement in energy transmission ratio and irradiation distance of laser systems, the quality of optical parts has also increased. Nanoprecision manufacturing requires the full-frequency band error to converge to the nanometer order of magnitude. At this time, the surface shape error and the medium- and high-frequency roughness at the macroscopic scale will be in the same order of magnitude, and the correlation between them will be obviously enhanced. In recent years, our research group has vigorously developed ultraprecision cutting (Fig. 1), magnetorheological methods (Fig. 2), ion beam techniques, and cylindrical smoothing techniques (Fig. 3) to obtain full-band subnanoprecision optical surfaces.

(2) Nanoprecision intrinsic surface controllability generation method. The surface of monocrystalline silicon generally leads to some typical damage precursors such as absorbable impurities, cracks, and scratches during mechanical polishing. The types and densities of these damage precursors seriously restrict the damage resistance of optical components. As a new form of subsurface defect, the body before nanodamage can be divided into mechanical, pollution, and structure types. Our research group has conducted a series of investigations on the monocrystalline silicon intrinsic surface processing method and the craft. It removes the optical component surface defect (Fig. 5) and obtains the nanoprecision intrinsic surface through immersion polishing (Fig. 4) and ion beam technology (Fig. 6 and Fig. 7), which enhances the loading ability of monocrystalline silicon.

(3) Nanoprecision shape control combination process. To achieve the goal of nanoprecision surface shape control, our research group has realized a combination process of high precision and low defect (Fig. 8), which is

different from the simple connection conversion of traditional machining processes. The combined process reasonably distributes all the indexes to the entire process and realizes the high-precision and low-defect control manufacturing of monocrystalline silicon components (Fig. 11). Immersion smooth, ion beam modification, and postprocessing are used to optimize the defect restraint strategy and develop monocrystalline silicon substrates. Compared with the traditional process, the advantages of the combined process in improving the accuracy, reducing the absorption, and achieving good adaptability on paraboloid and cylindrical elements are verified. Full-frequency subnanoscale-accuracy manufacturing is realized on small-diameter planar components. Full-band error convergence and absorption precursor restraint are realized on large-aperture planar, parabolic, and cylindrical components and high-precision, low-absorption, and high-power laser monocrystalline silicon is processed component substrate.

Conclusion and Prospect The main achievements of high-precision and low-defect control manufacturing technology in the Precision Engineering Laboratory of National University of Defense Technology in recent years are reviewed. The high-precision and low-defect combination processing technology developed by our research group has been applied to the processing of monocrystalline silicon, which supports the development of high-power laser systems.

Key words optical fabrication; high-energy laser system; monocrystalline silicon element; immersion smooth polishing; ion beam polishing

OCIS codes 220.1250; 120.4610